



Научно стручно веће за природно математичке науке

Предмет: Образац о испуњавању услова за избор у звање наставника

Име и презиме

Snežana Djorić-Veljković

Datum rođenja

10 / 11 / 1963

Naziv i sedište ustanove/organizacije u kojoj je kandidat zaposlen

Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš

Radno mesto

Vanredni profesor

Datum prvog izbora u sadašnje zvanje

26.12.2011

Datum raspisivanja konkursa

07.07.2016

Način (mesto) objavljivanja

Dnevni list "Narodne novine"

Zvanje za koje je raspisan konkurs

Vanredni profesor ili redovni profesor

Uža naučna oblast

Primenjena fizika

1. Doktorat nauka iz oblasti za koju se bira

(naziv doktorske disertacije, naučna oblast, godina i mesto odbrane)

"Uticaj testova pouzdanosti na efekte zračenja kod VDMOS tranzistora snage", Fizika nanokomponentata, 2006. god. Elektronski fakultet u Nišu

Doktorska disertacija je rezultat rada na naučno-istraživačkim projektima osnovnih nauka, odnosno osnovnih istraživanja u oblasti fizike: "Fizika, modelovanje i karakterizacija dielektričnih slojeva za MOS nanokomponente" i "Fizika, modelovanje i karakterizacija pojava u tankim slojevima kod MOS nanokomponentata".

2. Pozitivna ocena nastavnog rada

(naziv dokumenta, naziv ustanove/organizacije koja je izdala dokument, datum izdavanja)

Dokument usvaja Izorno veće Građevinsko-arhitektonskog fakulteta

3. Ostvarene aktivnosti bar u četiri elementa doprinosa široj akademskoj zajednici iz člana 4. kriterijuma

(opis aktivnosti, podaci o dokumentima)

1. Podržavanje vannastavnih akademskih aktivnosti studenata: Učešće u organizovanju studentske konferencije "IV

Međunarodni simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine - PHIDAC 2012", 27 - 28. septembar 2012, Niš, i član Organizacionog odbora ove konferencije. U periodu od 2013. do 2015. godine aktivno pružanje podrške zainteresovanim studentima u pripremi i realizaciji postavki za festivale nauke "Nauk nije bauk".

2. Učešće u radu tela fakulteta i univerziteta:

- od 2014. do sada član Veća Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta u Nišu;
- od 2010. do sada član Komisije za obezbeđenje kvaliteta na Građevinsko - arhitektonskom fakultetu;
- od 2007. do sada član Komisije za nastavu;
- u periodu od 2009. do 2013. predsednik Komisije za rangiranje kandidata za upis u I godinu osnovnih akademskih studija;
- 2009. i 2010. član Komisije za sprovođenje konkursa za upis u I godinu osnovnih akademskih studija;
- 2003, 2004. i u periodu od 2007. do 2013. član Komisije za sprovođenje prijemnog ispita za upis u I godinu osnovnih akademskih studija;
- 2012. član Komisije za pregled i ocenu prijemnog ispita za predmet Fizika na Tehnološkom fakultetu, a 2013. i predsednik ove komisije;
- u periodu od 2007. do 2011. učestvovala u radu grupe za sprovođenje studentskog vrednovanja na Građevinsko - arhitektonskom fakultetu;
- član Nastavno-naučnog veća Građevinsko - arhitektonskog fakulteta.

3. Rukovođenje aktivnostima na fakultetu i univerzitetu: Na Građevinsko - arhitektonskom fakultetu obavljala poslove prodekana za finansijsko-materijalna pitanja od 2009. do 2012. godine.

4. Doprinos aktivnostima koje poboljšavaju ugled i status fakulteta i Univerziteta: Na Građevinsko - arhitektonskom fakultetu u toku 2008. i 2009. godine, kao i 2013. i 2014. godine radila u okviru grupe koja je pripremala materijal za akreditaciju i ponovnu akreditaciju Fakulteta i njegovih studijskih programa. U periodu od 2009. do 2012. godine član radne grupe Preparation group for joint doctoral studies - grupe za prioremu zajedničkih doktorskih studija koje bi organizovali Ruhr-University Research School Bochum i fakulteti iz Beograda, Skoplja, i Niša, a u okviru DYNET/SEEFORM-a. Učešće u promociji Fakulteta u periodu od 2009. do 2012. godine.

5. Organizacija i vođenje lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnih i naučnih konferencija i skupova: Član Organizacionog odbora međunarodne konferencije "International Conference Innovation as a Function of Engineering Development - IDE2011", 25. - 26. September 2011, Niš. Aktivno učešće u pripremi konferencije.

6. Učešće na lokalnom, regionalnim, nacionalnim ili internacionalnim umetničkim manifestacijama (izložbe, festivali, umetnički konkursi i sl.), konferencijama i skupovima: Učešće i sa uspehom prezentovanje svojih radova na većem broju internacionalnih i nacionalnih konferencija i skupova kao što su MIEL, IDE, ISPS, CAS, TELSIS, ETRAN, I&A.

7. Uspešno izvršavanje zaduženja vezanih za nastavu, mentorstvo, profesionalne aktivnosti namenjene kao doprinos lokalnoj ili široj zajednici: Predavanje na Građevinsko - arhitektonskom fakultetu u okviru manifestacije Girl's day 2012 koja je podržana od GIZ (German International Cooperation). Uspešno držanje nastave iz više predmeta na Građevinsko - arhitektonskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu.

4. Mentorstvo ili komentorstvo bar jedne doktorske disertacije

4 zamena: jedan naučni rad u časopisu kategorie M21 ili M22, ili jedan udžbenik ili jedna monografija (rad, udžbenik i monografija se ne računaju u stavovima 6., 8. i 9.)

1. 1. S. Golubović, S. Đorić-Veljković, I. Manić, V. Davidović, "Efekti naprezanja oksida gejtja VDMOS tranzistora snage", Monografija, Elektronski fakultet Niš, Edicija monografije (2006). ISBN: 86-85195-16-0 0 (u monografiji su prezentovani rezultati dobijeni radom na projektu programa osnovnih istraživanja u oblasti fizike)

2. A. Jovanović, P. Pejić, S. Djorić-Veljković, J. Karamarković, M. Djelić, "Importance of building orientation in determining daylighting quality in student dorm rooms: Physical and simulated daylighting parameters' values compared to subjective survey results", Energy and Buildings, vol. 77, pp. 158-170 (2014) ISSN: 0378-7788 DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.03.048 doi:10.1016/j.enbuild.2014.03.048 <http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0378778814002680> (M21)

5. Ostvareni rezultati u razvoju naučno-nastavnog podmlatka, i to u barem jednom od sledećih elemenata: učešćem u komisijama za odbranu doktorske disertacije, magistarske teze ili master rada, držanjem nastave na doktorskim studijama, držanjem priprema studenata za studentska takmičenja, učešćem u završnim radovima na specijalističkim i master studijama i slično

1. Član Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije koja je odbranjena na Elektronskom fakultetu 2010. godine, kandidata Vojkana Davidovića. Na Mašinskom fakultetu u periodu od 2012. do 2014. godine član Komisija za pregled, ocenu i odbranu jednog diplomskog rada i tri master rada. Na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu 2016. godine član Komisija za pregled i odbranu jednog diplomskog rada i tri master rada.

2. Držanje nastave na studijskim programima doktorskih studija.

6. Od izbora u prethodno zvanje objavljen udžbenik ili monografija iz oblasti za koju se bira

Snežana Đorić-Veljković, Momčilo Kocić, Marija Stojanović-Krasić, "Fizika - elektricitet, optika, atomska i nuklearna fizika", Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, 2015. ISBN: 978-86-89429-09-1

7. Učešće u međunarodnim ili domaćim naučnim projektima

Učešće u radu na pet naučno-istraživačkih projekata osnovnih istraživanja u oblasti fizike finansiranih od strane resornog ministarstva Republike Srbije.

Učešće u radu na međunarodnom naučnom projektu koji je realizovan u saradnji Katedre za Mikroelektroniku Elektronskog fakulteta sa Institutom za fiziku čvrstog stanja Bugarske akademije nauka u Sofiji.

8. Od izbora u prethodno zvanje jedan rad objavljen u časopisu koji izdaje Univerzitet u Nišu ili fakultet Univerziteta u Nišu ili sa SCI liste, u kojem je prvopotpisani autor rada

Snežana Đorić-Veljković, Sofija Rančić, Predrag Janković, "Primena optičkih vlakana za uvođenje svetlosti u objekte", Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, no. 28, pp. 185-194 (2013) UDK: 666.189.21:666.22:628.9
<http://www.gaf.ni.ac.rs/index1.php>

9. Od prvog izbora u prethodno zvanje 18 poena ostvarenih objavljivanjem naučnih radova u časopisima kategorija M21, M22, M23, u skladu sa načinom bodovanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Bar na jednom radu kandidat mora biti prvopotpisani autor.

Od izbora u prethodno zvanje, u svim navedenim radovima (1 kategorije M21, 3 kategorije M22 i 3 kategorije M23) su prezentovani rezultati dobijeni radom na projektu programa osnovnih istraživanja u oblasti fizike OI171026. Prvopotpisani autor - na dva rada.

1. I. Manić, D. Danković, A. Prijić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, Z. Prijić, and N. Stojadinović, "NBT Related Degradation and Lifetime Estimation in p-Channel Power VDMOSFETs Under the Static and Pulsed NBT Stress Conditions", *Microelectronics Reliability*, vol. 51, no. 9-11, pp. 1540 - 1543 (2011) ISSN: 0026-2714, DOI: 10.1016/j.microrel.2011.06.004
https://www.researchgate.net/publication/256815516_NBT_related_degradation_and_lifetime_estimation_in_p-channel_power_VDMOSFETs_under_the_static_and_pulsed_NBT_stress_conditions (M23)

2. D. Danković, I. Manić, A. Prijić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, Z. Prijić, and N. Stojadinović, "Effects of Static and Pulsed Negative Bias Temperature Stressing on Lifetime in p-Channel Power VDMOSFETs", *Informacije MIDEM-Journal of Microelectronics Electric Components and Materials*, vol. 43, iss. 1, pp. 58-66 (2013) ISSN: 0352-9045 Accession Number: WOS:000318180100008 [http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_43\(2013\)1p58.pdf](http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_43(2013)1p58.pdf) (M23)

3. S. Djorić-Veljković, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Comparison of Gamma-Radiation and Electrical Stress Influences on Oxide and Interface Defects in Power VDMOSFETs", *Nuclear Technology & Radiation Protection*, vol. 28, no. 4, pp. 406-414 (2013) ISSN: 1451-3994 DOI: 10.2298/NTRP1304406D 10.2298/NTRP1304406D
http://ntrp.vinca.rs/2013_4/Contents2013_4.html (M22)

4. S. Djorić-Veljković, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Annealing Influence on Recovery of Electrically Stressed Power Vertical Double-Diffused Metal Oxide Semiconductor Transistors", *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 54, no. 6, article number. 064101-1-7 (2015) ISSN: 0021-4922 DOI: 10.7567/JJAP.54.064101
<http://dx.doi.org/10.7567/JJAP.54.064101> <http://iopscience.iop.org/1347-4065/54/6/064101/> (M23)

5. D. Danković, N. Stojadinović, Z. Prijić, I. Manić, V. Davidović, A. Prijić, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, "Analysis of Recoverable and Permanent Components of Threshold Voltage Shift in NBT Stressed P-Channel Power VDMOSFET", *Chinese Physics B*, vol. 24, no. 10, pp. 106601-1-9 (2015) ISSN: 1674-1056 DOI: 10.1088/1674-1056/24/10/106601
<http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-1056/24/10/106601/pdf> (M22)

6. D. Danković, I. Manić, A. Prijić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, N. Stojadinović, Z. Prijić, S. Golubović, "Negative Bias Temperature Instability in P-Channel Power VDMOSFETs: Recoverable Versus Permanent Degradation", *Semiconductor Science and Technology*, vol. 30, pp.105009-1-9 (2015) ISSN: 0268-1242 DOI: 10.1088/0268-1242/30/10/105009
<http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0268-1242/30/10/105009/meta;jsessionid=52BBCB92FFAF8242695F1FB5776FF642.c1.iopscience.cld.iop.org> (M22)

7. V. Davidović, D. Danković, A. Ilić, I. Manić, S. Golubović, S. Djorić-Veljković, Z. Prijić, N. Stojadinović, "NBTI and Irradiation Effects in P-Channel Power VDMOS Transistors", *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 63, no. 2, pp. 1268-1275 (2016) ISSN: 0018-9499, DOI: 10.1109/TNS.2016.2533866

[http://apps.webofknowledge.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID:\(M21\)](http://apps.webofknowledge.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=(M21))

10. Šest naučnih radova radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima

Radovi u kojima su prezentovani rezultati dobijeni radom na projektima osnovnih istraživanja u oblasti fizike:

1. S. Djorić-Veljković, D. Danković, A. Prijić, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, Z. Prijić and N. Stojadinović, "Degradation of p-channel Power VDMOSFETs under Pulsed NBT Stress", Proc. 27th International Conference on Microelectronics (MIEL 2010), Niš, May 2010 (pp. 443-446) (M33)
2. I. Manić, D. Danković, S. Djorić-Veljković, A. Prijić, V. Davidović, S. Golubović, Z. Prijić, and N. Stojadinović, "Negative Bias Temperature Instability in p-Channel Power VDMOSFETs Under Pulsed Bias Stress", Proc. 10th International Seminar on Power Semiconductors (ISPS 2010), Prague (Czech Republic) September 2011 (pp. 173-178) (M33)
3. S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović, "Efekti NBT naprezanja i odžarivanja kod P-kanalnog VDMOS tranzistora snage", Zbornik radova III konferencije za ETRAN, Palić, 08-12 jun 2008., str. MO1.3-1-4. (M63)
4. S. Djorić-Veljković, V. Davidović, D. Danković, I. Manić, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Recovery Treatment Effects on Gamma Radiation Response in Electrically Stressed Power VDMOS Transistors", Proc. 29th International Conference on Microelectronics (MIEL'14), Belgrade, May 2014 (pp. 293-296) DOI: 10.1109/MIEL.2014.6842146 (M33)
5. D. Danković, A. Prijić, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, Z. Prijić, N. Stojadinović, S. Đorić-Veljković, "Određivanje perioda pouzdanog rada p-kanalnih VDMOS tranzistora snage podvrgnutih kontinualnim i impulsnim NBT naprezanjima", Zbornik radova LVI konferencije za ETRAN, Zlatibor, 11-14 Jun 2012, str. MO1.1-1- MO1.1-4. (M63)
6. S. Djorić-Veljković, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, N. Stojadinović, "Uticao odžarivanja na oporavak električno napreznih VDMOS tranzistora snage", Zbornik radova LVII konferencije za ETRAN, Zlatibor, 3-6. jun 2013 (str. MO1.2-1-6) (nagrađen rad) (M63)

Od izbora u prethodno zvanje (pored radova 4-6) saopšteni su i radovi:

7. S. Đorić-Veljković, J. Karamarković, "Challenges and Possibilities of Application of OLED Light Sources", Proc. Innovation as a Function of Engineering Development (IDE 2011), Niš, 25 -26 November 2011 (pp. 103-108) publisher: Faculty of Civil engineering and Architecture ISBN: 978-86-80295-98-5, COBISS.SR - ID 187462412 (M33)
8. Snežana Đorić-Veljković, Sofija Rančić, Predrag Janković, Bojan Rančić, "Using Novel Systems and Installations for Introducing Daylight", Proc. of 9th Scientific Technical Conference Contemporary Theory and Practice in Building Development, Banja Luka, 11. -12. April, 2013 (pp. 405-413) ISBN: 978-99955-630-8-0 (M33)
9. D. Randjelović, M. Vasov, J. Karamarković, S. Djorić-Veljković, H. Krstic, "The influence of interior colors for efficient energy consumption", Proc. of 2013 - "Color in all directions", Third International Color Conference for the Southeast European Countries, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 18. - 20. June, 2013 (pp. 557-567) ISSN: 1313-4884 (M33)
10. S. Djorić-Veljković, J. Karamarković, D. Randjelović, M. Vasov, H. Krstic, "Room surfaces colours and interior lightening", Proc. of 2013 - "Color in all directions", Third International Color Conference for the Southeast European Countries, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 18. - 20. June, 2013 (pp. 577-589) ISSN: 1313-4884 (M33)
11. A. Jovanovic, S. Djorić-Veljković, J. Karamarkovic, P. Pejic, "Towards determining daylighting conditions in student dormitories-a South Eastern Europe Case Study", Proc. of World Sustainable Buildings Conference Barselona, (WSB 14), Barcelona, 28-30 October 2014 (vol. 4, session 136, pp. 395-1-7) ISBN: 978-84-697-1815-5 (M33)
12. S. Djorić-Veljković, S. Rančić, "Innovative Systems and Installation for Providing of Light Into the Buildings", Zbornik radova III Naučno-stručnog simpozijuma Instalacije & arhitektura I&A, Beograd, 8. novembar 2012, str. 183-189. ISBN: 978-86-7924-086-6 (M63)

11. Ostvarenih deset citata naučnih radova kandidata u drugim naučnim radovima objavljenim u naučnim časopisima kategorija M21, M22, M23 (izuzimajući autocitate i citate saradnika, odnosno kocitate)

Prema podacima Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u Beogradu, na osnovu pretraživača Web of Science, ukupan broj heterocitata u periodu od 2011. godine do sada je 66, što je i dato u zvaničnoj potvrdi u prilogu na NPAO. Takođe je u prilogu data i bibliografija citiranih radova za period 2011-2016. godine. Na osnovu ovog priloga se vidi da od 2011. godine postoji više od 40 citata naučnih radova kandidata u drugim naučnim radovima objavljenim u naučnim časopisima kategorija M21, M22, M23 (izuzimajući autocitate i citate saradnika, odnosno kocitate).

Ovde je naveden deo citata:

a.21 S. Djorić-Veljković, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Annealing of Radiation-Induced Defects in Burn-In Stressed Power VDMOSFETs", Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 26, no. 1, pp. 18 - 24 (2011) citirali su:

1. V.Dj. Vukić, P.V. Osmokrović, "Power Lateral PNP Transistor Operating With High Current Density in Irradiated Voltage

Regulator", Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 28, no. 2, pp. 146-157 (2013) DOI:10.2298/NTRP1302146V
http://ntrp.vinca.rs/2013_2/2_2013Vukic_pp_146_157.pdf

2. V. Dj. Vukić, P.V. Osmokrović, "Impact of the Excess Base Current and the Emitter Injection Efficiency on Radiation Tolerance of a Vertical PNP Power Transistor in a Voltage Regulator", Informacije MIDEM-Journal of Microelectronics Electronic Components and Materials, vol. 43, iss. 1, pp. 27-40 (2013) <http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84880993715&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-79958218364&src=s&imp=t&sid=D3974A4B1D3F43FE726FC426A7321BD3.y7ESLndDisN8cE7qwvy6w%3a140&sot=cite&sdt=a&>

3. V.E.Vukić, P.V. Osmokrović, "Gamma-Radiation response of isolated collector vertical PNP power transistor in moderately loaded voltage regulator L4940V5", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 15, iss. 9-10, pp. 1075-1083 (2013) <http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84890092607&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-79958218364&src=s&imp=t&sid=32A3D4647B5F6CD745CB9A1DB3CA5A09.N5T5nM1aaTEF8rE6yKCR3A%3a140&sot=cite&sdt=>

a.19 I. Manić, D. Danković, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Effects of Low Gate Bias Annealing in NBT Stressed p-Channel Power VDMOSFETs", Microelectronics Reliability, vol. 49, no. 9-11, pp. 1003 - 1007 (2009)
citirali su:

1. Wing-Shan Tam, Sik-Lam Sju, Bing-Liang Yang, Chi-Wah Kok, Hei Wong, "Off-State Drain Breakdown Mechanisms of VDMOS with anti-JFET Implantation", Microelectronics Reliability, vol. 51, pp. 2064 - 2068 (2011)
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271411003258>

a.14 D. Danković, I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović, and N. Stojadinović, "NBT Stress-Induced Degradation and Lifetime Estimation in p-Channel Power VDMOSFETs", Microelectronics Reliability, vol. 46, pp. 1828-1833 (2006)
citirali su:

1. Zhang Yue, Zhuo Qing-Qing, Liu Hong-Xia, Ma Xiao-Hua, and Hao Yue, "Flat-roof phenomenon of dynamic equilibrium phase in the negative bias temperature instability effect on a power MOSFET", Chinese Physics B, vol. 23, no. 5, article number: 057304, pp. 057304-1- 057304-4 (2014) ISSN 1674-1056, DOI: 10.1088/1674-1056/23/5/057304 <http://iopscience.iop.org/1674-1056/23/5/057304/>

a.13 N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, and S. Dimitrijević, "Electrical Stressing Effects in Commercial Power VDMOSFETs", IEE Proc. - Circuits, Devices and Systems, vol. 153, pp. 281-288 (2006)
citirali su:

1. A.N. Tallarico, P. Magnone, G. Barletta, A. Magri, E. Sangiorgi, and C. Fiegna, "Negative Bias Temperature Stress Reliability in Trench-Gated P-Channel Power MOSFETs", IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, vol. 14, no. 2, pp. 657-663 (2014) ISSN 1530-4388 DOI 10.1109/TDMR.2014.2308580
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6748885&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxppls%2Fabs_all.jsp
2. A. N. Tallarico, P. Magnone, G. Barletta, et al., "Influence of bias and temperature conditions on NBTI physical mechanisms in p-channel power U-MOSFETs", Solid-State Electronics, vol. 108, pp. 42-46 (2015)
http://apps.webofknowledge.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/full_record.do?product=UA&search_mode=CitingArticles&qid=13&SID=

a.12 N. Stojadinović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, I. Manić, S. Golubović, "Negative Bias Temperature Instability Mechanisms in p-Channel Power VDMOSFETs", Microelectronics Reliability, vol. 45, pp. 1343-1348 (2005)
citirali su:

1. A.N. Tallarico, P. Magnone, G. Barletta, A. Magri, E. Sangiorgi, and C. Fiegna, "Negative Bias Temperature Stress Reliability in Trench-Gated P-Channel Power MOSFETs", IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, vol. 14, no. 2, pp. 657-663 (2014) ISSN 1530-4388 DOI 10.1109/TDMR.2014.2308580
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6748885&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxppls%2Fabs_all.jsp

a.8 N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković, I. Manić, V. Davidović, and S. Golubović, "Effects of Burn-in Stressing on Radiation Response of Power VDMOSFETs", Microelectronics Journal, vol. 33, pp. 899-905 (2002)
citirali su:

1. X. F. Wang, G. C. Fu, C. Gao, J. Y. Yao, "A Probability Assessment Method for Degradation of Bridge Power MOSFET Circuit Based on Common Turn-On State", Applied Mechanics and Materials, vol. 160, pp. 125-129 (2012)
http://scholar.google.com/scholar?cites=8679574888181662679&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=en

a.6 N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković, I. Manić, V. Davidović and S. Golubović, "Radiation Hardening of Power VDMOSFETs Using Electrical Stress", Electronics Letters, vol. 38, pp. 431-432 (2002)
citirali su:

1. A. Shaukat, Y. Gao, J.A. Kuo, B.A. Bowen, P.E. Mort, "Visual classification of waste material for nuclear decommissioning", Robotics and Autonomous Systems, vol. 75, pp. 365-378 (2016) DOI:10.1016/j.robot.2015.09.005
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WS1/My%20Documents/2016%20Rob%20and%20Aut%20S%20Gao%20%20%201-

a.5 N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović, and S. Dimitrijević, "Mechanisms of Positive Gate Bias Stress Induced Instabilities in Power VDMOSFETs", *Microelectronics Reliability*, vol. 41, pp. 1373-1378 (2001)

citirali su:

1. F. Palumbo, A. Faigon, G. Curro, "Electrical Correlation of Double-Diffused Metal-Oxide-Semiconductor Transistors Exposed to Gamma Photons, Protons, and Hot Carriers", *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 58, no. 5, pp. 1476 - 1482, (2011)

ISSN: 0018-9383

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5741000

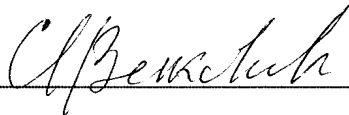
a.3 N. Stojadinović, S. Golubović, V. Davidović, S. Djorić-Veljković and S. Dimitrijević, "Modeling Radiation-Induced Mobility Degradation in MOSFETs", *Physica Status Solidi (a)*, vol. 169, pp. 63-66 (1998)

citirali su:

1. S.S. Rathod, A.K. Saxena, S. Dasgupta, "Modeling of threshold voltage, mobility, drain current and subthreshold leakage current in virgin and irradiated silicon-on-insulator fin-shaped field effect transistor device", *Journal of Applied Physics*, vol. 109, issue 8, Article .number: 084504, (2011) DOI: 10.1063/1.3553836, ISSN: 00218979

http://jap.aip.org/resource/1/japiau/v109/i8/p084504_s1?isAuthorized=no

Potpis kandidata: _____



Napomena: Kandidat je dužan da popunjen, odštampan i potpisan obrazac o ispunjavanju uslova za izbor u zvanje nastavnika dostavi fakultetu koji je objavio konkurs zajedno sa ostalom dokumentacijom kojom dokazuje da ispunjava uslove konkursa.

22. 07. 2016. ĩ.